

硅 NPN 外延平面达林顿晶体管芯片

■ 用途

- * 电源调整管
- * 音频功率放大器
- * 其他电子电路

■ 极限值 (Ta=25°C)

参数名称	符号	额定值	单位
最大集电极电流	I_{CM}	2	A
耗散功率	P_{tot}	2	W
结温	T_j	150	°C
贮存温度	T_{stg}	-55~150	°C

■ 电特性 (Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	典型值	最小值	最大值	单位
集电极--基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C=0.1mA, I_E=0$	260	150		V
集电极--发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=10mA, I_B=0$	150	100		V
发射极--基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E=1mA, I_C=0$		4		V
集电极--基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=150V, I_E=0$			1	μA
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=100V, I_B=0$			1	μA
发射极--基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=10V, I_C=0$	1.3		2.5	mA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=5V, I_C=1A$		2K	15K	
集电极--发射极饱和电压	V_{CES}	$I_C=3A, I_B=12mA$	1.2		1.8	V



注意事项:

- 1、芯片存储条件（推荐）：氮气（99%）保护，温度 $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ， $10\% \leq \text{湿度} \leq 55\%$ 。
- 2、此款产品发货之日起质保期为半年。
- 3、本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新。
- 4、任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用本产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。
- 5、本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准。